



Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры p-p-n переключающий. Предназначен для применения в переключающих и усилительных схемах. Выпускается в пластмассовом корпусе, тип корпуса КТ 27-2. Масса транзистора не более 0,6 г.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кэ} = 3 В, I_k = 150 мА, t_n < 30 мкс, Q > 50$ 25 100
 Граничная частота коэффициента передачи тока при $U_{кэ} = 10 В, I_k = 50 мА$ 200 1300 МГц

Граничное напряжение при $I_k = 10 мА, I_б = 0, t_n < 30 мкс, Q > 50$, не менее	36 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_k = 150 мА, I_б = 15 мА, t_n < 30 мкс, Q > 50$	0,1 0,65 В
Напряжение насыщения база эмиттер при $I_k = 150 мА, I_б = 15 мА, t_n < 30 мкс, Q > 50$	0,7 1,2 В
Время рассасывания при $I_k = 150 мА, I_б = 15 мА, t_n < 30 мкс, Q > 50$	0,005 0,1 мкс
Емкость коллекторного перехода при $U_{кэ} = 10 В, f = 10 МГц$	3,5 5 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{эб} = 0 В, I_k = 0, f = 10 МГц$	20 30 пФ
Обратный ток коллектора при $U_{кэ} = 50 В$, не более	
$T = +25^{\circ}C$	10 мкА
$T = +125^{\circ}C$	100 мкА
$T = -60^{\circ}C$	10 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 5 В$, не более	
$T = +25^{\circ}C$	100 мкА
$T = +125^{\circ}C$	300 мкА
$T = -60^{\circ}C$	100 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор база	50 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер	45 В
Постоянное напряжение эмиттер база	4 В
Постоянный ток коллектора	300 мА
Импульсный ток коллектора ¹	700 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при температуре корпуса $-60 \dots +50^{\circ}C$	0,3 Вт

Допустимая импульсная рассеиваемая мощность коллектора³ при температуре корпуса $-60 \dots +50^{\circ}C$ 0,45 Вт
 Температура p-n перехода $+150^{\circ}C$
 Температура окружающей среды $-60 \dots +125^{\circ}C$

¹ При $t_n < 5 мкс, Q \geq 30$

² При температуре корпуса $+50 \dots 125^{\circ}C$ постоянная рассеиваемая мощность коллектора снижается линейно на 3 мВт/ $^{\circ}C$.

³ При температуре корпуса $+50 \dots 125^{\circ}C$ допустимая импульсная рассеиваемая мощность коллектора снижается линейно на 4,5 мВт/ $^{\circ}C$.

Собственная резонансная частота транзистора 8,9 кГц. Крепление транзистора к теплоотводу производится методом прижима через резиновую прокладку, ограничивающую нагрузку на транзистор. Толщина прокладки 1...1,5 мм, твердость 58,8...137,2 Н/см², усадка прокладки $0,3 \pm 0,1$ мм. Соединение выводов транзистора с монтажными проводами рекомендуется производить импульсной дуговой сваркой в защитной среде. Длительность сварочного импульса 0,01 с, энергия импульса 100...200 Дж. Допускается повторная сварка не более 2-х раз. После монтажа допускается заливка объема с транзистором электроизоляционными компаундами с температурой полимеризации не более $+125^{\circ}C$.

